

СОДЕРЖАНИЕ

Том 41, номер 2, 2012

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ

Особенности трехмерного моделирования кин моп-транзисторов с непрямым затвором

А. А. Глушко, В. А. Шахнов

83

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Получение магнитных микро- иnanoструктур методом сканирующей зондовой литографии

А. А. Бухараев, Д. А. Бизяев, Н. И. Нургазизов, Т. Ф. Ханипов

90

Влияние радиационных дефектов на диффузию мышьяка и сурьмы в имплантированном кремнии

М. Джадан, А. Р. Челядинский, В. Ю. Явид

98

КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА

NV-центры в алмазе. Часть I. Общие сведения, технология изготовления, структура спектра

А. В. Цуканов

104

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Микроэлектромеханические преобразователи

В. П. Драгунов, Д. И. Остертак

120

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ

ВАХ и ширина спектра при туннелировании электронов сквозь наносэндвичи

W-WO₂-(Au₁₄₇)—Al₂O₃—Al и Nd-Nd₂O₃—(Au₅₅)—Nd₂O₃—Nd.

Часть I: квантово-химический расчет энергий орбиталей анионов нанокластеров Au₅₅ и Au₁₄₇

В. А. Жуков, В. Г. Маслов

136

СХЕМОТЕХНИКА

Характеристики чувствительности субмикронных двухфазных КМОП инверторов к воздействию отдельных ядерных частиц

С. И. Ольчев, В. Я. Стенин

146